

产品介绍

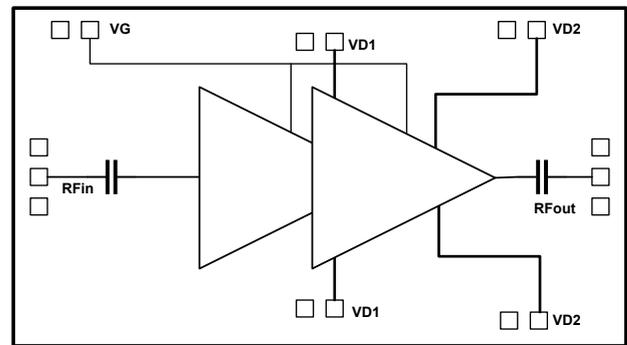
YGPA112-0207A1 是一款性能优良的 GaN 功率放大器芯片，频率范围覆盖 2~6.5GHz，可在连续波和脉冲模式下使用。脉冲模式下，VD=+28V 时，小信号增益典型值 26dB，饱和输出功率典型值 42dBm，饱和功率附加效率典型值 44%。

该芯片采用了片上通孔金属化工艺，保证良好接地，不需要额外的接地措施，使用简单方便。芯片背面进行了金属化处理，适用于共晶烧结工艺。

关键技术指标

- 频率范围：2-6.5GHz
- 小信号增益 (Pulse)：26dB
- 饱和输出功率 (Pulse)：42dBm
- 饱和功率附加效率 (Pulse)：44%
- 输入回波损耗 (Pulse)：17dB
- 供电 (Pulse)：520mA@+28V
- 芯片尺寸：4.25mm×2.25mm×0.075mm

功能框图



电性能表 (TA=+25°C, VD=+28V, VG=-2.7V*, IDQ=520mA, Pulse 模式)

参数名称	符号	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	Freq	2	—	6.5	GHz
小信号增益	Gain	23.5	26	—	dB
输入回波损耗	RL_IN	12	17	—	dB
饱和输出功率	Psat	40	42	—	dBm
饱和功率附加效率	PAE	37	44	—	%
饱和动态电流	IDD	—	1.45	1.53	A
饱和功率增益	Gp	14	16.5	—	dB

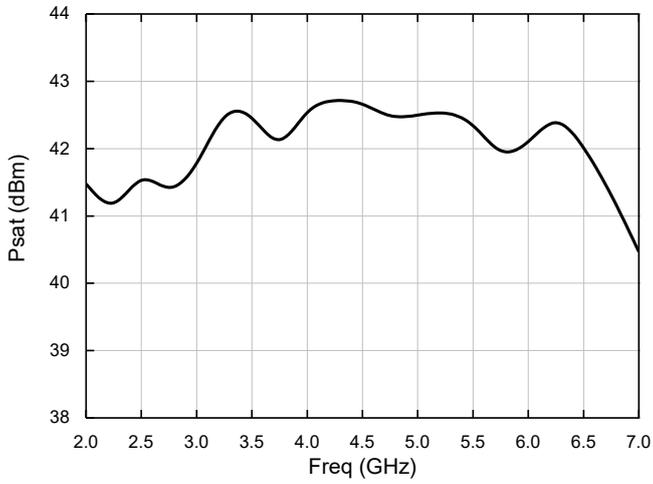
* 在-3~-2V范围内调节VG，使静态工作电流为520mA。参考值：VG=-2.7V for Pulse。

使用限制参数

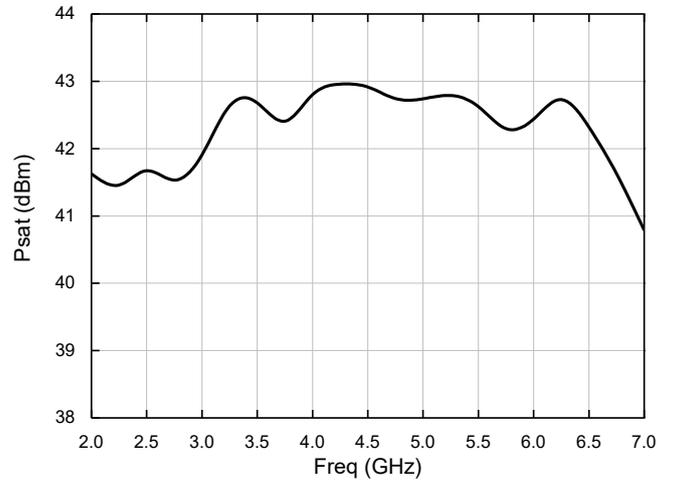
最大漏极工作电压	+32V
最小栅极工作电压	-5V
最大输入功率	+30dBm
贮存温度	-65°C~+150°C
工作温度	-55°C~+125°C

测试曲线 ($T_A=+25^{\circ}\text{C}$, $V_D=+28\text{V}$, $V_G: -2.75\text{V}$ for CW, -2.7V for Pulse; Pulse模式测试条件: 100us/1ms)

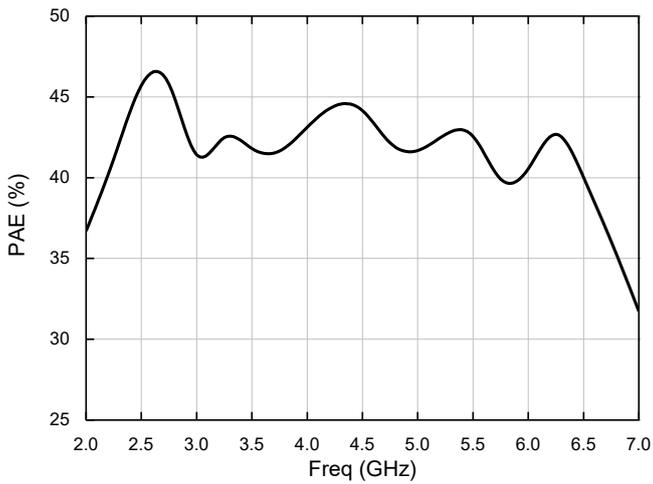
饱和输出功率 (CW)



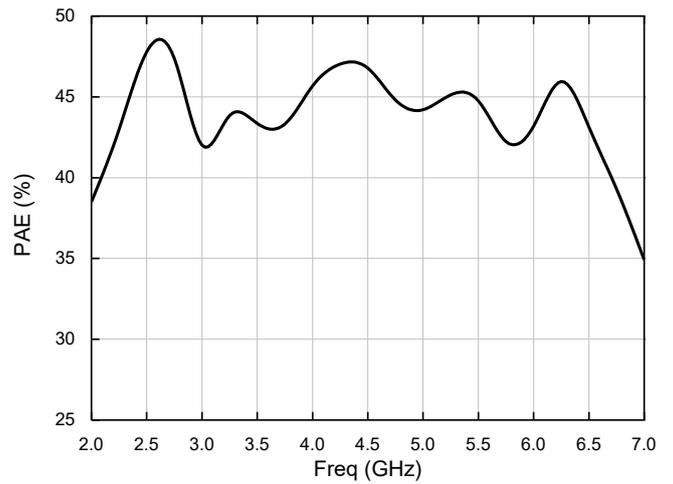
饱和输出功率 (Pulse)



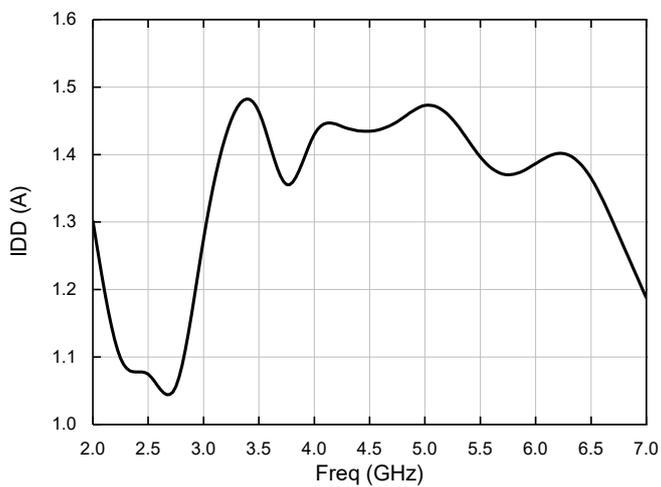
功率附加效率 (CW)



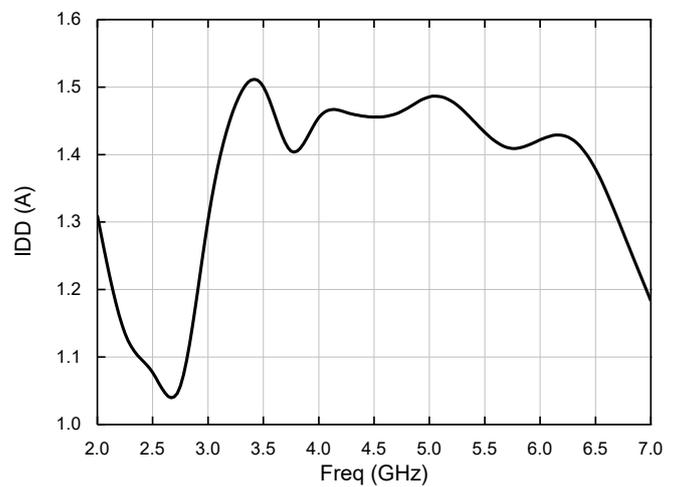
功率附加效率 (Pulse)



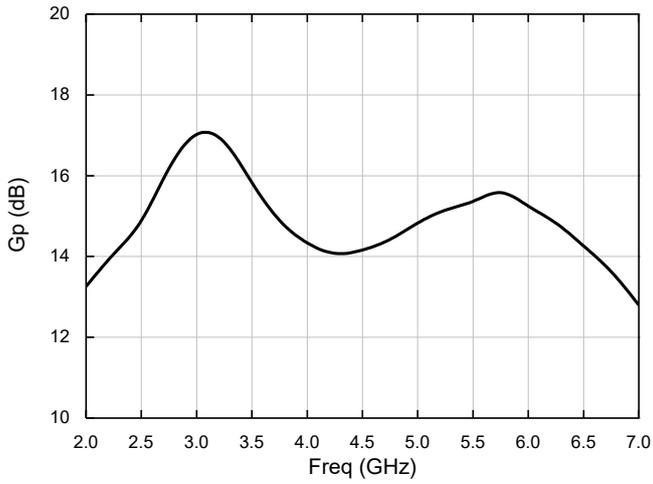
动态电流 (CW)



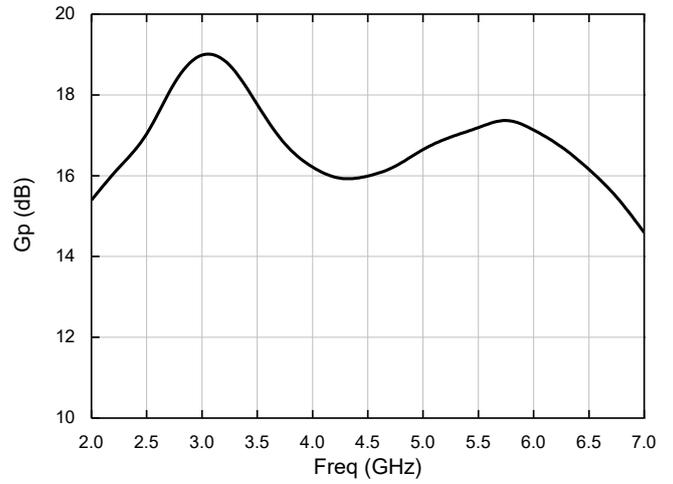
动态电流 (Pulse)



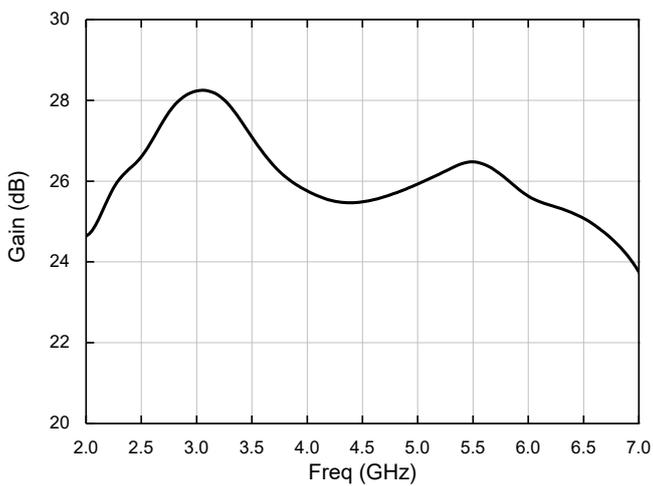
功率增益 (CW)



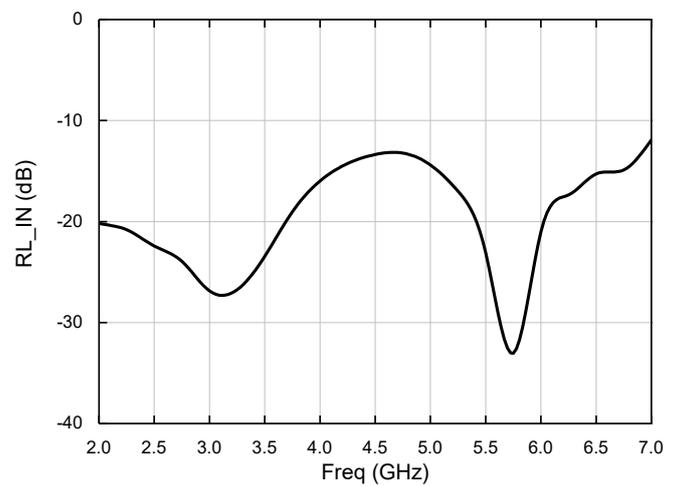
功率增益 (Pulse)



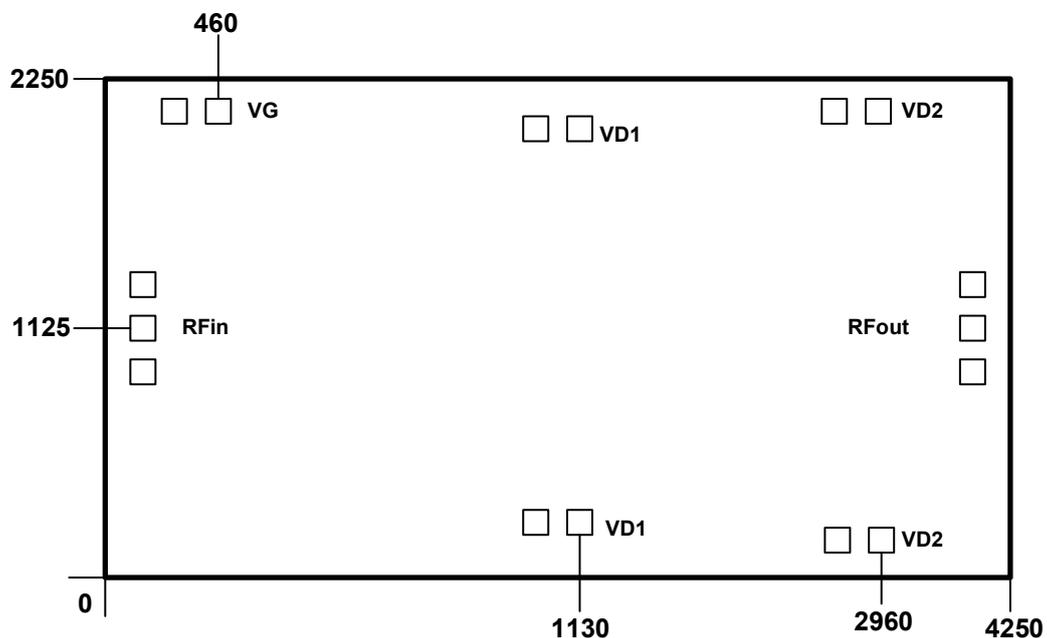
小信号增益



输入回波损耗

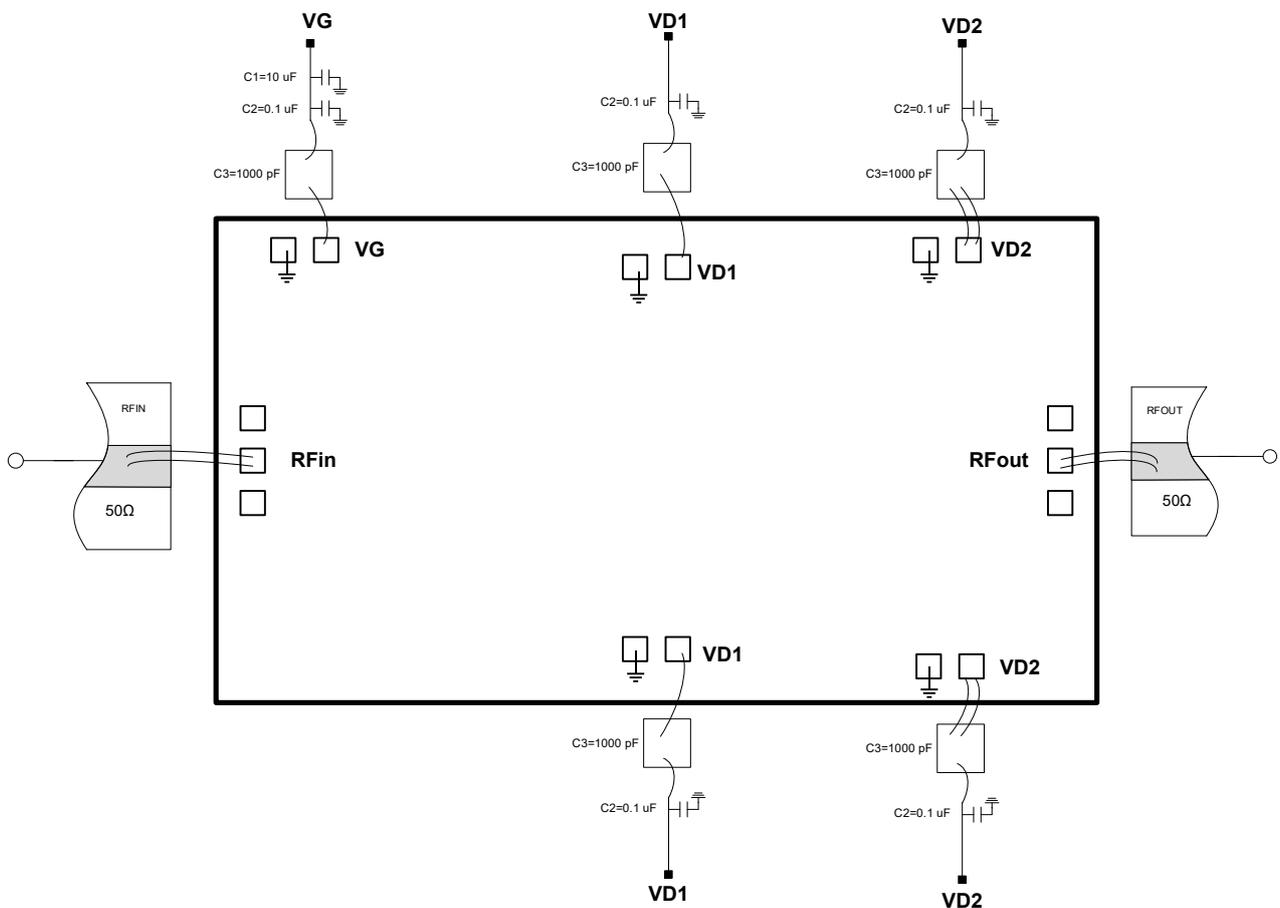


芯片端口图 (单位: μm)



端口定义

端口名	定义	信号或电压
RFin	射频信号输入，集成隔直电容	RF
RFout	射频信号输出，集成隔直电容	RF
VG	栅极馈电端，需外置 1000pF、0.1μF 和 10μF 电源滤波电容	-2.7V
VD1、VD2	漏极馈电端，需外置 1000pF 和 0.1μF 电源滤波电容	+28V

建议装配图

注意事项

- 1) 在净化环境装配使用；
- 2) SiC 材料很脆，芯片表面很容易受损伤（不要碰触表面），使用时必须小心；
- 3) 输入输出用 2 根键合线（直径 25μm 金丝），键合线尽量短，不要长于 600μm；
- 4) 烧结温度不要超过 300℃，烧结时间尽可能短，不要超过 30 秒；
- 5) 本品属于静电敏感器件，储存和使用注意防静电；
- 6) 干燥、氮气环境储存；
- 7) 不要试图用干或湿化学方法清洁芯片表面。